

روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه‌فاز

عبدالرضا مالکی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

محمد رضا ذوالقدری (استادیار)

سید جواد مهدوی (دانشیار)

دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

استفاده از روش مدولاسیون فضای برداری (SVM) برای محاسبه و اعمال زمان‌های کلیدزنی در مبدل‌ها، به افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت مبدل، نسبت به مدولاسیون پهنه‌ای پالس سینوسی (SPWM) می‌انجامد. در این مقاله ضمن بررسی روش SVM، به طریق سه‌بعدی، روش جدیدی برای محاسبه زمان‌های مربوط به بردارهای صفر پیشنهاد شده است که علاوه بر بهبود خواص هارمونیکی ولتاژ فازها، تلفات کلیدزنی را تا ۳۳ درصد کاهش می‌دهد. روش پیشنهادی در یک مدار عملی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج عملی ارائه شده‌اند.

در این نوشتار بعد از معرفی اصول SVM، روشی معرفی می‌شود

که علاوه بر بهبود خواص هارمونیکی ولتاژ فازها، تلفات کلیدزنی را نیز کاهش می‌دهد. در روش جدید برای زمان‌های کلیدزنی روابط جدیدی معرفی شده‌اند که کارایی SVM را افزایش می‌دهند. روش مذکور در یک سیستم عملی با SVM معمولی مقایسه شده است.

مقدمه

با گسترش روزافزون کاربرد مبدل‌های استاتیکی، روش‌های متنوعی برای کنترل ولتاژ آنها به وجود آمده است که اکثر آنها مبتنی بر مدولاسیون پهنه‌ای پالس (PWM) است. در این روش با اعمال کلیدزنی در زمان‌های مناسب، ولتاژ مورد نظر در خر裘ی ایجاد می‌شود. یکی از آخرین روش‌های PWM معرفی شده، روش مدولاسیون فضای برداری (SVM) است.^[۱] از مزیت‌های اصلی این روش افزایش ۱۵ درصدی دامنه‌ی هارمونیک اول ولتاژ خر裘ی مبدل نسبت به مدولاسیون پهنه‌ای پالس سینوسی (SPWM) است. اگرچه در روش‌های پیچیده‌تر SPWM سعی شده با تغییر شکل موج مرجع این تفاوت جبران شود^[۲]، سایر مزایای روش SVM، نظیر کاهش فرکانس کلیدزنی، همگونی بیشتر با روش‌های کنترل برداری و...، باعث شده که در کاربردهای جدید معمولاً این روش به سایر روش‌ها ترجیح داده شود.

برای بهبود خواص SVM روش‌هایی پیشنهاد شده‌اند که روش‌های^[۳] BCSVM و^[۴] RSVM از آن جمله‌اند.^[۶-۷]

مدولاسیون فضای برداری
در سیستم سه‌فاز سه‌سیمه‌یی که مجموع ولتاژها و یا جریان خطوط آن در هر لحظه مساوی صفر است، دو درجه آزادی وجود دارد. لذا می‌توان مقادیر لحظه‌یی ولتاژ را با دو بردار متعادل^[۸] V_a و^[۹] V_β نمایش داد. بدین منظور از تبدیل کلارک استفاده می‌شود:^[۱]

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_\beta \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad (1)$$

در نهایت بردار ولتاژ سه‌فاز در نمایش دو بعدی به صورت زیر

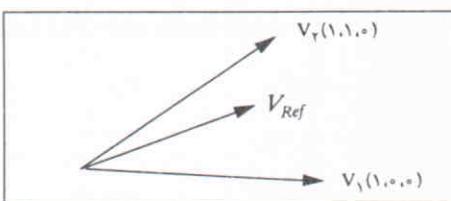
$$V = V_a + j V_\beta \quad (2)$$

برای یک سیستم سه‌فاز سینوسی متعادل که دامنه‌ی ولتاژ سه‌فاز یکسان است، اندازه‌ی بردار V برابر دامنه‌ی ولتاژ فاز است و بردار با سرعت زاویه‌یی^[۱۰] که فرکانس زاویه‌یی ولتاژ سه‌فاز است، در جهت خلاف عقربه‌های ساعت گردش می‌کند. بدین ترتیب، مکان هندسی انتهای این بردار دایره‌بی به شعاع دامنه‌ی ولتاژ سینوسی است.

استفاده از روش BCSVM باعث کاهش تلفات کلیدزنی و ساده‌تر شدن تحقق عملی روش SVM می‌شود ولی اعوجاج ولتاژ

فازها را افزایش می‌دهد.^[۱۱]

در روش RSVM تغییر فرکانس کلیدزنی به صورت تصادفی باعث کاهش اثر تداخل الکترومغناطیسی (EMI) حاصل از کلیدزنی می‌شود.^[۱۲] این روش معمولاً برای کاهش نویز صوتی مبدل‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.^[۱۳]



شکل ۳. بردار ولتاژ مرجع.

ولتاژ موجود در یک ناحیه، از ترکیب بردارهای مجاور آن ناحیه استفاده می‌شود. مثلاً، در شکل ۳ بهترین حالت کلیدزنی برای ایجاد بردار V_{Ref} ، حالت‌های ۱ و ۲ و ۱۱۰ و ۱۰۰ بدهمراه بردارهای صفر است. در صورتی که وضعیت خروجی مبدل از یک حالت به حالت دیگر فقط با کلیدزنی در یک شاخه مبدل انجام شود، حداقل تغییر کلیدزنی یا MST^* رخ داده است.^[۱]

با تقسیم مناسب پریود PWM به زمان اعمال بردارهای مختلف در یک پریود، می‌توان بردار مرجع مورد نظر را به دست آورد.

بنابراین:

$$V_{Ref} T_s = V_1 T_1 + V_2 T_2 \quad (3)$$

که در آن:

$$T_1 + T_2 < T_s \quad (4)$$

T_1 زمان اعمال بردار V_1 , V_2 زمان اعمال بردار V_2 , V_{Ref} و T_s پریود PWM است. در SVM معمولی بقیه پریود بردارهای صفر به طور مساوی اعمال می‌شوند.

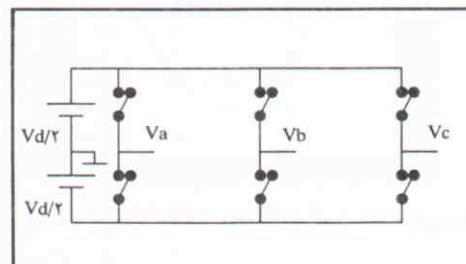
نمایش تبدیل SVM در فضای سه بعدی
در روش SVM بردار (V_a, V_b, V_c) با دو بردار (V_α, V_β) (نمایش داده می‌شود، در نگاه اول از فضایی با سه درجه آزادی به فضایی با دو درجه آزادی وارد شده‌ایم، بنابراین پس از محاسبه زمان‌های کلیدزنی در فضای (V_α, V_β) و برگشت به فضای (V_a, V_b, V_c) جواب یکنایی خواهیم داشت. راه حل مشکل در روش SVM، در نظر گرفتن این روش برای سیستم متعدد است. بنابراین ما یک معادله اضافی به صورت $0 = V_a + V_b + V_c$ نیز خواهیم داشت که همراه با دو معادله مربوط به V_α, V_β یکتا بودن پاسخ را تضمین می‌کند.

در روش SVM در مورد ولتاژ خطوط شرط $V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} = 0$ به ازای همهٔ حالات کلیدها برقرار است. بنابراین با اعمال زمان‌های کلیدزنی، ولتاژ خطوط به صورت یکتا با دامنهٔ $\sqrt{3} V_{Ref}$ به دست می‌آید. ولی در مورد ولتاژ فازها نسبت به مرکز dc ورودی، شرط $0 = V_a + V_b + V_c$ به دلیل وضعیت کلیدها در قسمت قدرت برقرار نمی‌باشد. اگر اندازهٔ $V_a + V_b + V_c$ کلیدها در

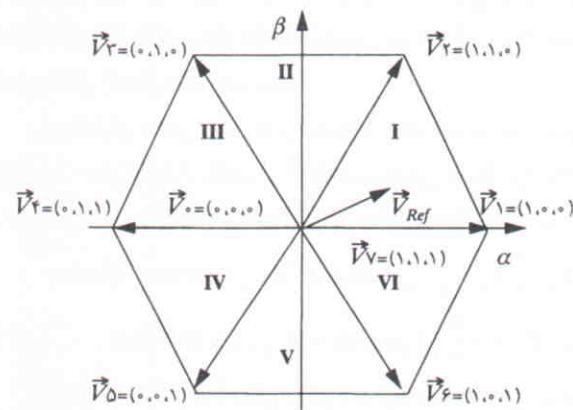
نمایش برداری معرفی شده را می‌توان به خروجی یک مبدل سه‌فاز نیز تعیین داد. شما می‌ساده‌ی یک مبدل سه‌فاز در شکل ۱ نشان داده شده است. با در نظر گرفتن شش کلید و این شرط که دو کلید موجود در یک شاخه نمی‌توانند همزمان روشن باشند، جملاً هشت حالت برای وضعیت‌های مختلف کلیدها به وجود می‌آید. منتظر با این هشت حالت، هشت بردار ولتاژ توسط مبدل ایجاد می‌شود. با اعمال تبدیل رابطهٔ ۱ به ولتاژ خروجی مبدل در وضعیت‌های مختلف کلیدها، شکل ۲ بدست می‌آید.

چنان‌که مشاهده می‌شود هشت وضعیت کلیدزنی موجب ایجاد شش بردار غیر صفر و دو بردار صفر متناظر با حالت‌های ۱۱۱ و ۰۰۰ می‌شود. فاصله‌ی بین دو بردار مجاور را «ناحیه» می‌نامیم. دو بردار مجاور تنها در وضعیت کلیدهای یک بازو با یکدیگر متفاوت‌اند و این بدان معنی است که برای ایجاد بردار مجاور یک بردار، تنها یک بازوی مبدل تغییر وضعیت خواهد داد.

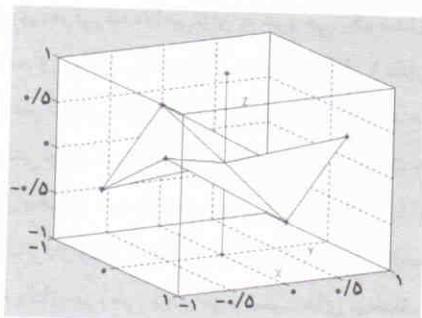
بدین ترتیب می‌توان گفت که بردار لحظه‌ی خروجی مبدل یکی از هشت بردار مذکور است که بعنوان بردارهای ولتاژ پایه در نظر می‌گیریم. برای ایجاد بردار ولتاژ دلخواه از ترکیب بردارهای پایه استفاده می‌شود. بردارهای پایه به گونه‌ی انتخاب می‌شوند که متوسط زمانی آنها برابر بردار مورد نظر باشد. بدین منظور برای ایجاد



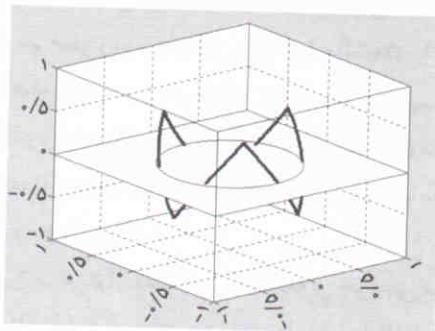
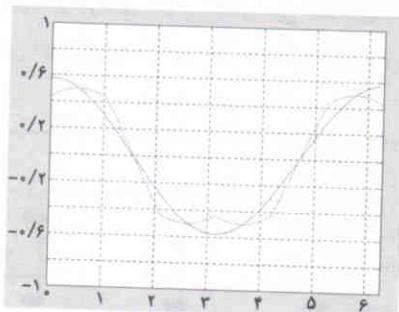
شکل ۱. شما می‌ساده‌ی یک مبدل سه‌فاز.



شکل ۲. نمایش برداری ولتاژ خروجی مبدل سه‌فاز در صفحه (α, β) .



شکل ۴. نمایش فضایی بردارهای ولتاژ فاز خروجی مبدل سه‌فاز.

شکل ۵. مکان $(V_\alpha, V_\beta, V_\gamma)$ برای یک سیستم متعادل.

شکل ۶. شکل موج ولتاژ فاز و محل تقاطع آن با ولتاژ مرجع سینوسی.

شکل ۵. V_γ شود، یعنی منحنی بر صفحه‌ی xoy منطبق شود. در شکل ۵ مکان رسم شده، صفحه‌ی xoy را فقط در چند نقطه قطع می‌کند. این نقاط همان نقاط تلاقی ولتاژ SVM با منحنی $|V_{Ref}| \cos \omega t$ است که در شکل ۶ نشان داده شده است.

برای انطباق منحنی شکل ۵ بر صفحه‌ی xoy ، باید در هر پریود رابطه‌ی $V_\gamma = V_{Ref}$ برقرار باشد. از آنجا که وزن دهنی توسط بردارهای

راطی V_k ، V_{k+1} و V_γ انجام می‌شود، مطابق شکل ۴ خواهیم داشت:

$$\frac{3}{4}T_V - \frac{3}{4}T_0 + \frac{1}{2}T_k \cos k\pi + \frac{1}{2}T_{k+1} \cos(k+1)\pi = 0$$

$$T_V - T_0 = -\frac{2}{3}(T_k \cos k\pi + T_{k+1} \cos(k+1)\pi) \quad (6)$$

رابطه‌ی ۶ یک شرط اضافی برای زمان‌های کلیدزنی ایجاد می‌کند، که در صورت تحقق آن، صفر بودن مجموع ولتاژها تضمین

را برای هشت بردار ممکن به دست آوریم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} V_a + V_b + V_c &= -\frac{3}{2}V_d & V_0 \\ &= -\frac{1}{2}V_d & V_1 \\ &= +\frac{1}{2}V_d & V_2 \\ &= -\frac{1}{2}V_d & V_3 \\ &= +\frac{1}{2}V_d & V_4 \\ &= -\frac{1}{2}V_d & V_5 \\ &= +\frac{1}{2}V_d & V_6 \\ &= +\frac{3}{2}V_d & V_7 \end{aligned}$$

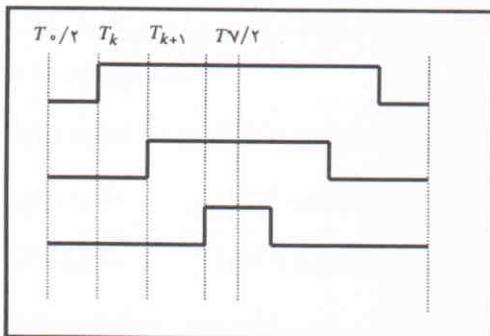
اگر به تبدیل کلارک، معادله‌ی $V_\gamma = \frac{3}{2}(V_a + V_b + V_c)$ را اضافه کنیم، خواهیم داشت:

$$\vec{V} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} V_\alpha \\ V_\beta \\ V_\gamma \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad (5)$$

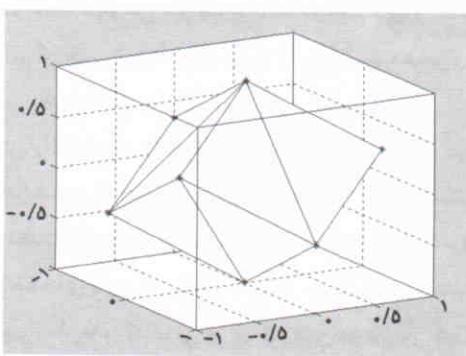
حال اگر تبدیل فوق را برای هشت حالت مجاز در شکل ۲، در فضای سه‌بعدی $(V_\alpha, V_\beta, V_\gamma)$ (رسم کنیم، شکل ۴ به دست خواهد آمد. x محور حقیقی (α)، y محور موهومی (β) و z محور V_γ را متعادل کنیم، خواهیم داشت.

چنان‌که اشاره شد، در روش SVM معمولی، مدت زمان اعمال بردار V_γ با مدت زمان اعمال بردار V_0 برابر است، یعنی بنابراین زمان‌های مربوط به دو بردار (V_0, V_γ) متعادل باشند. متناظر با V_γ (نگام متوسط گیری در طول یک پریود)، متناظر با V_0 روی V_γ حذف می‌شود. تصویر این مکان هندسی روی صفحه‌ی xy دایره‌بیی است. که شعاع آن با شعاع دایره‌ی محاطی در شش ضلعی شکل ۲ یکسان است. این مکان برای یک سیستم سه‌فاز متعادل باشرط $T_0 = T_V$ به صورت نشان داده در شکل ۵ خواهد بود. شکل ۶ تغییرات ولتاژ فاز با زمان را برای ساخت یک ولتاژ مرجع سینوسی توسط روش SVM نشان می‌دهد. بررسی شکل ۶ موج ولتاژ فاز، وجود هارمونیک سوم به صورت شبه مثابی را تأیید می‌کند. (شکل ۶)

بهبود خواص SVM با کنترل زمان‌های صفر برای داشتن شرط $V_a + V_b + V_c = 0$ بایستی در همه‌ی نقاط



شکل ۷. الگوی کلیدزنی.



شکل ۸. محدوده‌ی مجاز برای باقی ماندن در منطقه‌ی خطی.

اگر معادله‌ی ۱۱ را برای یک سیستم سه‌فاز متعادل حل کنیم،
یعنی $V_\gamma = 0$ در این صورت در ناحیه‌ی ۱ خواهیم داشت.

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{|V_{Ref}|}{V_d} T_s \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \omega t\right) \\ T_2 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{|V_{Ref}|}{V_d} T_s \cdot \sin(\omega t) \\ T_V - T_0 &= \frac{\sqrt{3}}{2} (T_1 - T_2) \end{aligned} \quad (12)$$

مطابق شکل ۷ داریم:

$$\begin{aligned} V_{A_0}(\omega t) &= \frac{V_d}{2T_s} \left(\frac{T_0}{2} + T_1 + T_2 + \frac{T_V}{2} + \frac{T_V}{2} + T_2 + T_1 - \frac{T_0}{2} \right) \\ &= \frac{V_d}{2T_s} \left(2T_1 + 2T_2 + \frac{2}{3}T_1 - \frac{2}{3}T_2 \right) = \frac{V_d}{T_s} \left(\frac{4}{3}T_1 + \frac{2}{3}T_2 \right) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{V_d}{T_s} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{|V_{Ref}|}{V_d} \left(2 \sin\left(\frac{\pi}{3} - \omega t\right) + \sin\omega t \right) \\ &= \frac{|V_{Ref}|}{V_d} \times V_d \cos\omega t \end{aligned} \quad (13)$$

می‌شود. با اضافه کردن معادله‌ی ۶ به تبدیل کلارک، معادلات ماتریسی به معادله‌ی ۷ تبدیل خواهد شد.

$$V_{Ref} = \begin{bmatrix} V_\alpha \\ V_\beta \\ V_\gamma \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad (7)$$

با در نظر گرفتن این که میانگین بردارها در یک پریود باید مساوی با V_{Ref} شود، چنانچه الگوی کلیدزنی به صورت شکل ۷ انتخاب شود به معادله‌ی ۸ خواهیم رسید.

$$V_{Ref} \cdot \frac{T_s}{2} = V_k \cdot T_k + V_{k+1} \cdot T_{k+1} + V_0 \cdot \frac{T_0}{2} + V_V \cdot \frac{T_V}{2} \quad (8)$$

از طرفی داریم:

$$\frac{T_s}{2} = \frac{T_0}{2} + \frac{T_V}{2} + T_k + T_{k+1} \quad (9)$$

از دو رابطه‌ی ۸ و ۹ خواهیم داشت:

$$(V_{Ref} - V_V) \frac{T_s}{2} = (V_k - V_V) T_k + (V_{k+1} - V_V) T_{k+1} + (V_0 - V_V) \frac{T_0}{2} \quad (10)$$

و بنابراین:

$$\begin{aligned} \frac{T_s}{2} \cdot \begin{bmatrix} V_\alpha \\ V_\beta \\ V_\gamma - V_d \end{bmatrix} &= \frac{1}{2} V_d \begin{bmatrix} \cos \frac{(k-1)\pi}{3} & \cos \frac{k\pi}{3} & 0 \\ \sin \frac{(k-1)\pi}{3} & \sin \frac{k\pi}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} \cos k\pi - \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \cos (k+1)\pi - \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_k \\ T_{k+1} \\ T_0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$

پس با استفاده از معادله‌ی ۱۱ برای هر V_a و V_b و V_c می‌توانیم زمان‌های کلیدزنی مناسب را محاسبه کرده، ولتاژهای مورد نظر را تولید کنیم. محدودیتی که وجود دارد در اندازه‌ی $|V_{Ref}|$ است. در حقیقت رابطه‌ی ۱۱ تا زمانی معتبر است و برای زمان‌های کلیدزنی مقادیر مشبّت می‌دهد، که مکان V_{Ref} در داخل چندوجهی مشخص شده توسط بردارهای V_1 تا V_V باشد — این چندوجهی در شکل ۸ نشان داده شده است. تصویر این چندوجهی روی صفحه xy همان شش ضلعی نمایش داده شده در شکل ۲ خواهد بود.

که همان ظرفیت مربوط به PWM معمولی است. از معادله ۶ نیز می‌توان به این نتیجه رسید. در حقیقت اگر بخواهیم بردار OA را بسازیم، اندازه $T_k + T_{k+1}$ صفر خواهد بود و اگر بخواهیم رابطه 6 را نیز برآورده کنیم در این صورت مجموع زمان‌های T_1 و T_2 و T_3 از T_5 بیشتر خواهد شد که امکان پذیر نیست. این وضعیت تا رسیدن به بردار $\overset{\rightarrow}{OC}$ همچنان باقی می‌ماند.

برای بردار $\overset{\rightarrow}{OC}$ داریم:

$$T_1 = \frac{3}{8} T_s$$

$$T_2 = 0$$

$$T_3 = 0$$

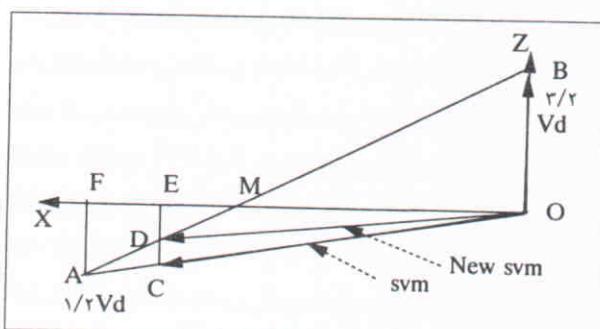
$$T_5 = \frac{1}{4} T_s \quad (16)$$

که شرط 6 را نیز برآورده می‌کند.

کاهش اعوجاج و لتاژ فازها نسبت به مرکز dc بدون کاهش ظرفیت مبدل

اگر در روش فوق بخواهیم مزیت افزایش 15 درصدی ظرفیت مبدل را نسبت به PWM معمولی داشته باشیم، باز هم می‌توانیم ولتاژ فازها را تا حد ممکن به سینوسی نزدیک کنیم. در شکل 10 اگر OE را به اندازه $V_{Ref,MAX}$ در روش SVM معمولی یعنی $\frac{1}{3} Vd$ در نظر بگیریم، در این صورت می‌توان در امتداد خط AB ، تا نقطه D به محور X نزدیک شد. خط AB تصویر محدوده چندوجهی شکل 8 روی صفحه xoz است. برای بردار $\overset{\rightarrow}{OD}$ باز هم ظرفیت مبدل همان $90/16$ درصد است، ولی اندازه OE و لتاژ شبهمثلثی به اندازه CE قابل توجهی کم شده است.

در شکل 10 ، اندازه OC بردار V_{Ref} برای داشتن حداکثر ظرفیت مبدل است. از روی شکل مشخص است که در این حالت دامنه OE و لتاژ شبهمثلثی متناسب با اندازه CE است و داریم:



شکل ۱۰. کاهش اندازه OE و لتاژ شبهمثلثی با تغییر زمان‌های T_1 و T_5 .

اگر محاسبات فوق را برای ناحیه‌های دیگر انجام دهیم به معادلات 14 خواهیم رسید.

$$V_A = |V_{Ref}| \cos \omega t \quad 0^\circ \leq \omega t < 2\pi$$

$$V_B = |V_{Ref}| \cos(\omega t - 120^\circ) \quad 0^\circ \leq \omega t < 2\pi$$

$$V_C = |V_{Ref}| \cos(\omega t + 120^\circ) \quad 0^\circ \leq \omega t < 2\pi \quad (14)$$

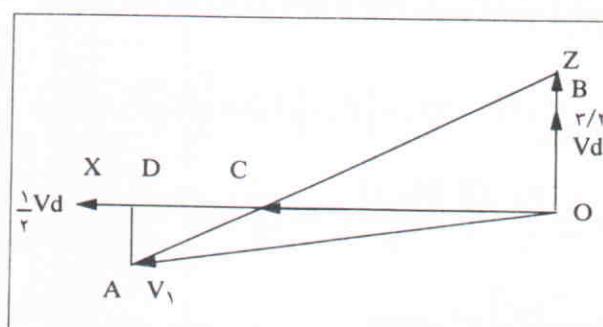
ولتاژ خطوط هم به صورت سینوسی کامل با اندازه $\sqrt{3} |V_{Ref}|$ خواهد بود. بدین صورت، ولتاژ فاز نسبت به مرکز dc به صورت کاملاً سینوسی خواهد بود. اما در علم برق و الکترونیک آموخته‌ایم که تغییر شرایط برای بهبود یک پارامتر، همواره باعث بدتر شدن وضعیت یک پارامتر دیگر در سیستم می‌شود.

روش ارائه شده در بالانیز از این قائد مستثنی نیست. در اینجا از دست دادن قسمتی از افزایش ظرفیت ولتاژ مبدل، بهایی است که برای بهبود وضعیت هارمونیک‌ها پرداخته می‌شود. برای درک بهتر این موضوع صفحه xoz را در شکل 9 در نظر می‌گیریم. مشاهده می‌کنیم که با تغییر زمان‌های کلیدزنی می‌توانیم بین دو بردار $\overset{\rightarrow}{OA}$ و $\overset{\rightarrow}{OB}$ حرکت کنیم. از طرفی چون مجموع زمان‌های مربوط به دو بردار تجاوز کنند، لذا بردار حاصل از وزندهی بردارهای $\overset{\rightarrow}{OA}$ و $\overset{\rightarrow}{OB}$ می‌تواند در داخل مثلث OAB واقع شود. پس اگر بخواهیم حداکثر اندازه OE بردار V_{Ref} را داشته باشیم و به محور OX نزدیک شویم (تشرط $V_{Ref} = V_d$) در این صورت حداکثر اندازه OE بردار V_{Ref} با $\overset{\rightarrow}{OC}$ خواهد شد:

$$\frac{OC}{OD} = \frac{OB}{OB + DA} \Rightarrow \frac{OC}{OD} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow (V_{Ref})_{MAX} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} Vd = \frac{1}{2} Vd$$

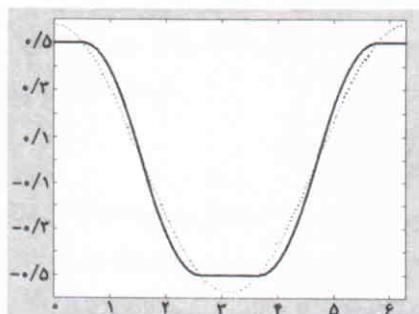
$$\Rightarrow m = \frac{\frac{1}{2} Vd}{\frac{\pi}{2} Vd} = \frac{78}{5} \quad (15)$$



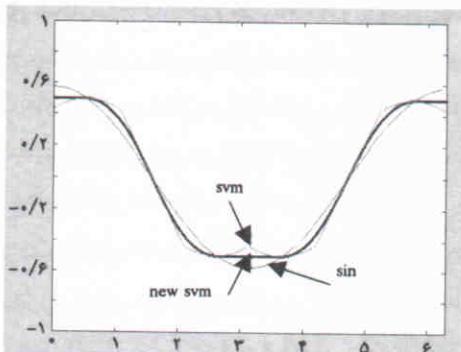
شکل ۹. صفحه xoz در شکل 8 .

در شکل ۱۲ شکل موج سینوسی کامل، شکل موج حاصل از SVM معمولی و شکل موج حاصل از روش SVM جدید، به تفکیک رسم شده‌اند و مشاهده می‌شود که در روش جدید به ولتاژ سینوسی نزدیک‌تر شده‌ایم.

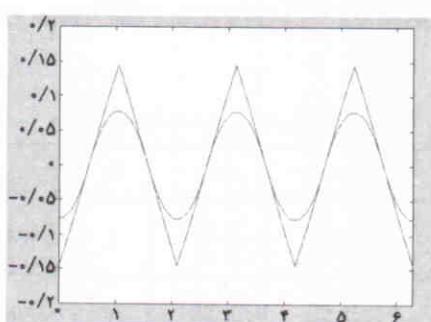
اگر اختلاف دو روش SVM و شکل موج سینوسی کامل را به دست آوریم، به شکل ۱۳ خواهیم رسید. یعنی به جای اضافه شدن ولتاژ مثلثی، به شکل موج سینوسی مرجع، یک شکل موج قطعه‌ی سینوسی هارمونی سوم به شکل موج سینوسی مرجع اضافه شده



شکل ۱۱. معادله فاز a با روش جدید SVM



شکل ۱۲. مقایسه شکل موج‌های SVM با موج سینوسی.



شکل ۱۳. ولتاژ شبهمثلثی در دو روش SVM

$$\frac{CE}{AF} = \frac{OE}{OF} \Rightarrow CE = \frac{OE}{OF} \times AF$$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{4\sqrt{3}}{3}} = \frac{9}{4\sqrt{3}} \quad (17)$$

در شکل ۱۰ ما می‌توانیم با تغییر مقادیر T_7 و T_7 به بردار \vec{OD} بررسیم، بدون اینکه ظرفیت مبدل کم شود. در این صورت اندازه‌ی دامنه‌ی ولتاژ شبهمثلثی با اندازه‌ی ED متناسب است و داریم:

$$\frac{ED}{AF} = \frac{EM}{MF} \Rightarrow ED = AF \times \frac{OE - OM}{OF - OM}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}} = \frac{9}{232} \quad (18)$$

از رابطه‌ی ۱۷ و ۱۸، درصد کاهش دامنه‌ی ولتاژ شبهمثلثی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

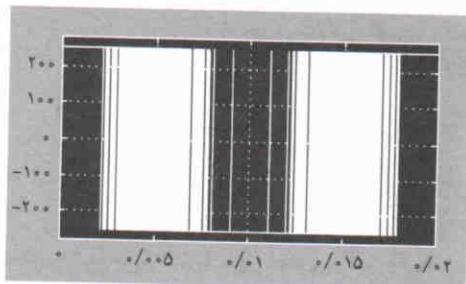
$$\frac{ED}{CE} = \frac{9/232}{9/433} = 0.52/57 \quad (19)$$

یعنی حدود ۴۶/۵ درصد دامنه‌ی هارمونیک‌های دیگر کاهش یافته است، بدون اینکه ظرفیت مبدل کم شود.

حال می‌پردازیم به روش محاسبه‌ی زمان‌های کلیدزنی برای داشتن حداقل هارمونیک‌ها و حداقل ظرفیت. برای این منظور برای نقطاطی که در شکل ۵ در زیر صفحه‌ی xoy قرار دارند T_7 را مساوی صفر و برای نقاط بالای صفحه‌ی T_7 را مساوی صفر قرار می‌دهیم. در این صورت معادلات مربوط به ولتاژ V_{AO} به صورت زیر خواهد بود.

$$\begin{aligned} V_{AO} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \times |V_{Ref}| & 0 \leq \omega t < \frac{\pi}{6} \\ &= |V_{Ref}| (\sin(\frac{2\pi}{3} - \omega t) - \frac{1}{\sqrt{3}}) & \frac{\pi}{6} \leq \omega t < \frac{3\pi}{6} \\ &= |V_{Ref}| (\frac{1}{\sqrt{3}} - \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})) & \frac{3\pi}{6} \leq \omega t < \frac{5\pi}{6} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} |V_{Ref}| & \frac{5\pi}{6} \leq \omega t < \frac{7\pi}{6} \\ &= |V_{Ref}| (\sin(\frac{2\pi}{3} - \omega t) + \frac{1}{\sqrt{3}}) & \frac{7\pi}{6} \leq \omega t < \frac{9\pi}{6} \\ &= |V_{Ref}| (\sin(\omega t - \frac{4\pi}{3}) - \frac{1}{\sqrt{3}}) & \frac{9\pi}{6} \leq \omega t < \frac{11\pi}{6} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} |V_{Ref}| & \frac{11\pi}{6} \leq \omega t < \frac{12\pi}{6} \end{aligned} \quad (20)$$

اگر معادلات ۲۰ را رسم کنیم، شکل موج فاز a به صورت شکل ۲۰ خواهد شد.

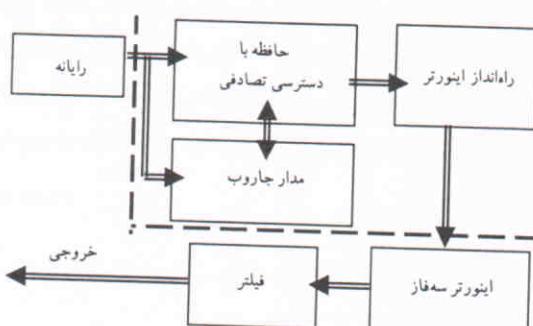


شکل ۱۵. کاهش تلفات کلیدزنی به میزان ۳۳ درصد در روش SVM جدید.

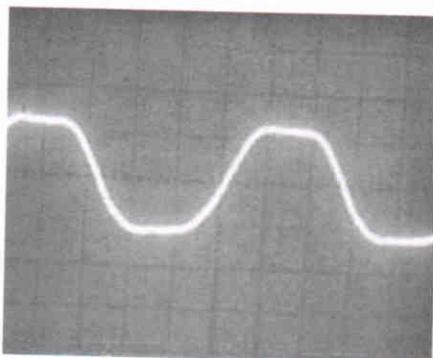
کلیدزنی است. عدم کلیدزنی با استفاده از نتایج شبیه‌سازی در شکل ۱۵ قابل مشاهده است.

نتایج عملی

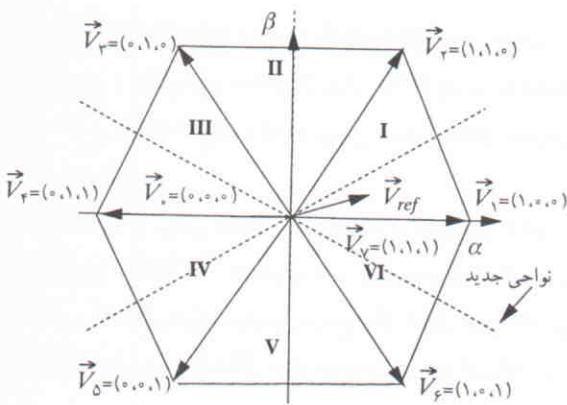
به منظور بررسی عملی نتایج بدست آمده، یک سیستم تجربی مطابق شکل ۱۶ طراحی و ساخته شد. نرم‌افزار تهیه شده که برای حالت کلی یک تولیدکننده هارمونیکی طراحی شده، قابلیت ایجاد شکل موج هارمونیکی انتخابی را دارد. به علاوه، امکان استفاده از SVM معمولی و یا SVM پیشنهادی نیز توسط نرم‌افزار ایجاد شده است. پس از محاسبه زمان‌های کلیدزنی توسط PC، اطلاعات شکل ۱۵ موج با دقت $1\mu sec$ روی یک حافظهی جانبی ذخیره می‌شود.



شکل ۱۶. نمودار مدار عملی.



شکل ۱۷. ولتاژ فاز ایجاد شده توسط مدار عملی (فیلتر شده).



شکل ۱۸. نواحی جدید برای اعمال بردار صفر.

است. بدین ترتیب از روی شکل، کاهش دامنه (دامنه‌ی ماکریم) به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\frac{VA}{VB} = \frac{0/\sqrt{773}}{0/\sqrt{144}} = \frac{0.52}{0.5} \quad (21)$$

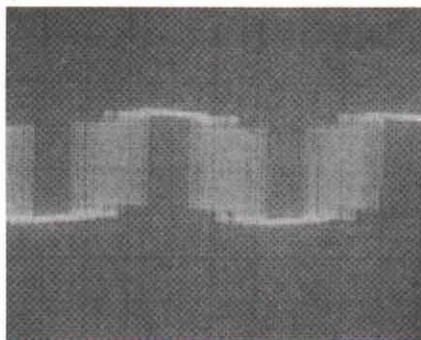
یعنی همان کاهش ۴۶/۵ درصدی که قبل از دست آوردیم. بنابراین لازم است با استفاده از موقعیت بردار مرتع در نواحی جدید شکل ۱۴، مدت زمان اعمال بردار صفر به مدت زمان اعمال بردار V_7 یا V_6 تبدیل شود.

مقایسهی شکل موج فاز خروجی SVM و روش پیشنهادی
به منظور مقایسهی روش پیشنهادی با روش SVM معمولی، محتویات هارمونیکی و شکل موج لحظه‌یی ولتاژها در جدول ۱ با یکدیگر مقایسه شده‌اند. این ضرایب با انتگرال‌گیری از معادلات شکل موج‌های شکل ۱۲ محاسبه شده‌اند.

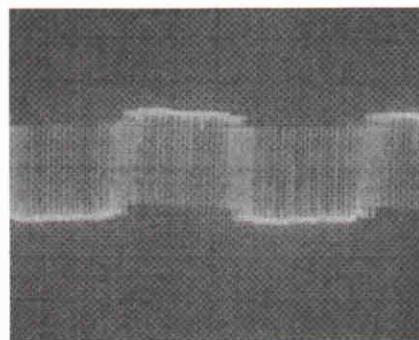
اگر به شکل ۱۲ دقت کنیم، خواهیم دید که در $\frac{1}{3}$ هر پریود، کلیدزنی متوقف می‌شود و ولتاژ برابر با $\frac{V_d}{2}$ یا $\frac{V_d}{3}$ است. در این مدت عمل کلیدزنی در آن شاخه انجام نمی‌شود. از آنجاکه در روش SVM معمولی فرکانس نمونه‌برداری و کلیدزنی برابر است، می‌توان نتیجه گرفت که عدم کلیدزنی برای دو بازوی 60° درجه‌یی در هر چرخه‌ی مؤلفه‌ی اصلی معادل ۳۳ درصد کاهش فرکانس متوسط

جدول ۱. ضرایب سری فوریه برای شکل ۱۲.

A15	A9	A3	A1	
$-\frac{3\sqrt{3}}{244}\pi$	$-\frac{3\sqrt{3}}{80}\pi$	$-\frac{3\sqrt{3}}{8}\pi$	۱	SVM معمولی
$-\frac{1\sqrt{3}}{560}\pi$	$-\frac{2\sqrt{3}}{80}\pi$	$-\frac{2\sqrt{3}}{8}\pi$	۱	SVM جدید



ب) روش جدید:



الف) روش معمولی:

شکل ۱۸. مقایسه کلیدزنی روش جدید SVM با روش معمولی.

باعث بالا رفتن ولتاژ فاز تا حد ۱/۱۵ برابر دامنه هارمونیک اول در روش SPWM می شود. در مواردی که دامنه ولتاژ کمتر از ۱ است، با کنترل زمان اعمال بردارهای صفر و T_7 و T_7 می توان دامنه هارمونیک سوم را به شدت کاهش داد. در حالتی که پخواهیم از حد اکثر ظرفیت مبدل استفاده کنیم، با کنترل زمان های T_7 و T_7 می توانیم دامنه ولتاژ شبه مثلثی را تا حد ۴۶/۵ درصد نسبت به SVM معمولی کم نماییم. استفاده از روش ارائه شده باعث کم شدن تعداد کلیدزنی به میزان ۳۳ درصد نسبت به SVM معمولی می شود. این در حالی است که وضعیت هارمونیکی شکل موج نیز به علت کاهش دامنه هارمونیک سوم بهتر می شود.

اطلاعات حافظه توسط یک شمارنده به ترتیب خارج و جهت قطع و وصل کلیدهای اینورتر توسط مدار راهانداز استفاده می شود و در نتیجه موجب قطع و وصل شدن کلیدهای مبدل می شود. در شکل ۱۷ ولتاژ فیلتر شده که توسط مدار عملی با استفاده از روش جدید SVM ایجاد شده، نشان داده شده است.

در شکل ۱۸ کلیدزنی روش جدید SVM با روش معمولی مقایسه شده است. عدم کلیدزنی در دو بازوی ۶۰ درجه بینی و در نتیجه کاهش فرکانس مؤثر کلیدزنی به میزان ۳۳ درصد مشهود است.

نتیجه گیری

وجود مؤلفه هارمونیک سوم در شکل موج ولتاژ فاز ناشی از SVM

پابلوشت

1. space vector modulation
2. Sinusoidal pulse Width Modulation (SPWM)
3. Pulse Width Modulation (PWM)
4. bus clamp space vector modulatio
5. Random SVM
6. minimum switching transition

4. Jobing, R. and Vandemon, F.S. "Digital implementation of bus clamp SVM", *IEEE Tran. On Energy Conversion*, 92, pp 334-348 (1993).

5. Ahmad, R.H., Karady, G.G., Blake, T.D. and Pinewski, P. "Comparison of space vector modulation techniques based on performance indexes and hardware implementation", *IECON* 97, 2, pp 682-687.

6. Boys, J.T. and Andrews, M. "Random PWM inverter drive systems: theory and practice", *IECON* 93, 2, pp 695-700.

7. Hui,S.Y.R., Sathiakumar, S. and Shrivastava, Y. "Noise characteristics of DC-AC random PWM inverters" *Seventh International Conference on Power Electronics and Variable Speed Drives*, pp 416-421 (1998).

8. Bourgeois, J.M. "PWM technique for acoustic noise reduction in power application", *APEC* 93, pp 141-145.

9. Covic, G.A. and Boys, J.T. "Noise quieting with random PWM AC drives", *Electric Power Applications, IEE Proceedings*, 145 Issue (1), pp 1-10 (Jan 1998).

منابع

1. Handely, P.G. and Boys, J.T. "Space vector modulation: an engineering review" *IEEE Transaction on Industrial application*, IA-23, pp. 87-91.
2. Stevanovic, V.R. and Vukosavic, S.N. "Space Vector PWM Voltage Control With Optimized Switching Strategy" *IEEE -IAS* 92 pp. 1025-33.
3. Hooldsworth, J.A. and Grant, D.A. "The use of harmonic distortion to increase the output voltage of three phase PWM inverter" *IEEE Trans. IA* (5), pp. 1224-28, (Sep/Oct 1984).